

1. 一种半导体装置，其特征在于，包括存储芯片及温度检测模块，所述温度检测模块用于检测所述存储芯片的温度，所述温度检测模块包括：
温度检测单元，所述温度检测单元包括温度敏感单元及可调电阻单元，所述温度敏感单元的导电性能随温度的变化而变化，所述可调电阻单元与所述温度敏感单元并联；
其中所述温度检测单元被配置为通过调整所述可调电阻单元的电阻值来对所述温度检测单元进行校准。
2. 根据权利要求1所述的半导体装置，其特征在于，所述可调电阻单元包括多个子电阻及多个开关，所述子电阻串联连接，每一所述开关至少与一个所述子电阻并联，通过改变多个所述开关的通断，来改变所述可调电阻单元的电阻值。
3. 根据权利要求2所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻的阻值相同。
4. 根据权利要求2所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻为多晶硅电阻或者N型扩散电阻或者P型扩散电阻。
5. 根据权利要求2所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻之间通过第一层金属线电连接，所述子电阻与所述开关之间通过第二层金属线电连接。
6. 根据权利要求2所述的半导体装置，其特征在于，所述温度检测单元还包括定值电阻，所述定值电阻与所述温度敏感单元串联，所述定值电阻包括第一端及第二端，所述定值电阻的第一端与电源电连接，所述定值电阻的第二端与所述温度敏感单元电连接。
7. 根据权利要求6所述的半导体装置，其特征在于，所述温度敏感单元为二极管，所述二极管的正端与所述定值电阻的第二端电连接，所述二极管的负端与接地端电连接。
8. 根据权利要求7所述的半导体装置，其特征在于，所述可调电阻单元包括第一端及第二端，所述子电阻设置在所述第一端与所述第二端之间，所述可调电阻单元的第一端与接地端电连接，所述可调电阻单元的第二端与所述定值电阻的第二端电连接。
9. 根据权利要求6所述的半导体装置，其特征在于，所述温度检测模块还包括A/D转换模块，具有输入端及输出端，所述输入端与所述定值电阻的第二端电连接，所述输出端输出数字信号，所述A/D转换模块用于将所述定值电阻第二端的模拟信号转换为数字信号。
10. 根据权利要求9所述的半导体装置，其特征在于，所述A/D转换模块包括：
电阻单元，具有第一端及第二端，所述电阻单元的第一端与电源电连接，所述电阻单元

的第二端与接地端电连接，所述电阻单元具有多个引出端，每一引出端的电压不同；多个比较单元，所述 A/D 转换模块输入端的信号作为所述比较单元的输入信号，所述电阻单元的多个引出端信号分别作为多个所述比较单元的参考信号，所述比较单元输出数字信号。

11. 根据权利要求 10 所述的半导体装置，其特征在于，所述 A/D 转换模块还包括编码单元，所述编码单元接收所述比较单元的数字信号，并进行编码。
12. 根据权利要求 10 所述的半导体装置，其特征在于，所述 A/D 转换模块还包括输出单元，所述输出单元与所述比较单元连接，用于将所述数字信号输出。
13. 根据权利要求 9 所述的半导体装置，其特征在于，所述电阻单元包括多个串联连接的子电阻，所述电阻单元的每一引出端与所述电阻单元的第二端之间间隔的子电阻的数量不同，以使每一引出端的电压不同。
14. 根据权利要求 13 所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻的电阻值相同或不同。
15. 根据权利要求 13 所述的半导体装置，其特征在于，所述电阻单元的每一引出端与所述电阻单元的第二端之间间隔的子电阻的数量以预设数值递增。
16. 根据权利要求 13 所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻为多晶硅电阻、N 型扩散电阻、P 型扩散电阻中的至少一种。
17. 根据权利要求 15 所述的半导体装置，其特征在于，所述子电阻之间通过第一层金属线电连接，所述电阻单元通过第二层金属线形成所述引出端。
18. 根据权利要求 1 所述的半导体装置，其特征在于，所述温度检测单元与所述存储芯片采用不同的电源供电。
19. 根据权利要求 17 所述的半导体装置，其特征在于，所述温度检测单元的供电早于所述存储芯片的供电。
20. 根据权利要求 1 所述的半导体装置，其特征在于，所述半导体装置还包括控制芯片，所述存储芯片及所述温度检测模块与所述控制芯片电连接。
21. 根据权利要求 20 所述的半导体装置，其特征在于，所述控制芯片用于在存储芯片启动之前对存储芯片进行加热，并判断所述温度检测单元检测的温度是否达到设定阈值，若达到设定阈值，则控制所述存储芯片启动。